

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Якимов Евгений Борисович
2	Дата рождения (полная)	17 ноября 1947 г.
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук, специальность – 01.04.10
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Институтская, д. 6 http://www.iptm.ru eagle@iptm.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук
	Ведомственная принадлежность организации	РАН
	Тип организации	НИИ
	Наименование подразделения	Лаборатория локальной диагностики полупроводниковых материалов
	Должность	Главный научный сотрудник
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS;</p> <p>для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alexander Y. Polyakov, Vladimir I. Nikolaev, Eugene B. Yakimov, Fan Ren, Stephen J. Pearton and Jihyun Kim, "Deep level defect states in β-, α-, and ϵ-Ga₂O₃ crystals and films: Impact on device performance", JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A, 40, 020804 (2022). 2. P. S. Vergeles, Yu. O. Kulanchikov, A. Y. Polyakov, E. B. Yakimov, S. J. Pearton, "Communication—Electron-Beam Stimulated Release of Dislocations from Pinning Sites in GaN", ECS Journal of Solid State Science and Technology 11.1, 015003, (2022) 3. In-Hwan Lee, Tae-Hwan Kim, A.Y. Polyakov, A.V. Chernykh, M.L. Skorikov, E.B. Yakimov, L.A. Alexanyan, I.V. Shchemerov, A.A. Vasilev, S.J. Pearton "Degradation by sidewall recombination centers in GaN blue micro-LEDs at diameters<30 μm", Journal of Alloys and Compounds 921, 166072, (2022) 4. V. I. Orlov, A.Y. Polyakov, P. S. Vergeles, E. B. Yakimov, Gyu Cheol Kim, In-Hwan Lee, "Estimations of activation energy for dislocation mobility in p-GaN", ECS Journal of Solid State Science and Technology 10.2, 026004 (2021): 5. Eugene B. Yakimov, Pavel S. Vergeles, Alexander Y. Polyakov, Ivan V. Shchemerov, A.V. Chernykh, A.A. Vasilev, A.I. Kochkova, In-Hwan Lee, S.J. Pearton, "Dislocations introduced in n-GaN at room temperature cause conductivity inversion", Journal of Alloys and Compounds 877; 160281 (2021) 6. P. S. Vergeles, E. B. Yakimov, A. Y. Polyakov, I. V. Shchemerov, A. V. Chernykh, A. A. Vasilev, A. I. Kochkova, In-Hwan Lee and Stephen J. Pearton, "Parasitic p-n junctions formed at V-pit defects in p-GaN", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 129, 	

	155702 (2021).
	7. O. V. Feklisova, E. E. Yakimov and E. B. Yakimov, "Study of single-layer stacking faults in 4H-SiC by deep level transient spectroscopy", APPL. PHYS. LETT., 116, 172101 (2020).
	8. P.S. Vergeles, V.I. Orlov, A.Y. Polyakov, E.B. Yakimov, Taehwan Kim, In-Hwan Lee "Recombination and optical properties of dislocations gliding at room temperature in GaN under applied stress." Journal of Alloys and Compounds 776 181-186. (2019)
	9. Seham K. Abdel-Aal, Ahmed S. Abdel-Rahman, Wafia M. Gamal, Mohamed Abdel-Kader, Hany S. Ayoub, Ashraf F. El-Sherif, M. F. Kandeel, S. Bozhko, E. E. Yakimov and E. B. Yakimov "Crystal structure, vibrational spectroscopy and optical properties of a one-dimensional organic-inorganic hybrid perovskite of [NH ₃ CH ₂ CH(NH ₃)-CH ₂]BiCl ₅ " Acta Cryst. B75, 880-886 (2019).
	10. Eugene B. Yakimov, Alexander Y. Polyakov, In-Hwan Lee, and Stephen J. Pearton, "Recombination properties of dislocations in GaN", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 123, 161543 (2018).
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты